BEST AVAILABLE COPY

PRODUCTION OF GRANULAR AND CELLULAR CHITOSAN DERIVATIVE HAVING SULFONE GROUP

Patent number:

JP2229832

Publication date:

1990-09-12

Inventor:

FUJITA HIROYUKI; ITOYAMA MITSUNORI

Applicant:

FUJI SPINNING CO LTD

Classification:

- international:

B01J39/22; C08H5/00

- european:

Application number:

JP19890051091 19890303

Priority number(s):

JP19890051091 19890303

Report a data error here

Abstract of JP2229832

PURPOSE:To obtain a derivative capable of providing an exchange resin, etc., stable within the whole pH range and having a high strength and desired sulfone groups by dissolving low-molecular weight chitosan into an acidic aqueous solution, dripping the resultant solution into a basic solution, coagulating the above-mentioned aqueous solution, then acetylating, crosslinking and sulfonating the obtained product. CONSTITUTION:Low-molecular weight chitosan is dissolved in an acidic aqueous solution and the obtained aqueous solution is then dripped into a basic solution and coagulated to a provide granular and cellular chitosan, which is subsequently acetylated with acetic anhydride, crosslinked with a diepoxy and then sulfonated with N,N'-dimenthylformamide-sulfur trioxide complex in the N,N'- dimenthylformamide to afford a granular cellular chitosan derivative having sulfone groups. The deacetylation degree is <=10%, preferably <=5% in the course of the reaction.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

® 公開特許公報(A) 平2-229832

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)9月12日

C 08 H 5/00 B 01 J 39/22 NVF

8215-4 J 8017-4 G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法

②特 願 平1-51091

②出 願 平1(1989)3月3日

 ⑩発 明 者 藤 田 裕 之 静岡県駿東郡小山町藤曲54-1

 ⑩発 明 者 糸 山 光 紀 静岡県駿東郡小山町小山129-1

⑪出 顋 人 富士紡績株式会社 東京都中央区日本橋人形町1丁目18番12号

個代 理 人 弁理士 大野 克躬 外1名

明細雲

1. 発明の名称

スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体 の製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 低分子位キトサンを酸性水溶液に溶解し、 該溶液を塩基性溶液中に落下, 疑固させた粒状多孔質 キトサンを無水酢酸によりアセチル化後、ジェボ

キシで架橋し、次いでN.N'ージメチルホルムアミド中でN,N'ージメチルホルムアミドー三酸化イオウ複合体によりスルホン化することを特徴とするスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法。

3、発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明はスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の製造方法に関し、イオン交換樹脂、クロマトグラフィー用担体等に好適な粒状多孔質キトサン誘導体を提供するものである。

【従来の技術】

キトサンのスルホン化法については従来から多くの文献等に記載があり、例えばエム・エル・ウォルフロム (N. L. Wolforn) 等の方法 (J. An. Chen. Soc., 81, 1764 (1958)) では、フレーク状のキトサンをピリジン中クロルスルホン酸で反応させるか、もしくは N, N'ージメチルホルムアミド中 N, N'ージメチルホルムアミドー三酸化イオウ複合体による反応により、 N, Oースルホン化物を得ている。又、

ナガサワ等(Chen. Pharm. Bull., 20, 157(1972))はみ鏡酸による Nースルホン化を、特開昭 60 ー 20362号は鏡酸及びクロルスルホン酸との混合物によりβーDー(1→4)ーグルコサミンサブュニットのC-6 位の水酸基への 0ースルホン化物を得ることを開示している。また粒状多孔質キヘキサメチレンジイソシアネート等で架橋後サンジイソシアネート等で架橋後サンシールスルホン酸で N, 0ースルホン化するによるドウルスルホン酸で N, 0ースルホンにスルホンになっため、水に可溶性となりと観水性が増大するため、水に可溶性となり

田体としての使用は不適当である。また特別図 63 - 274457号の粒状多孔質キトサン誘導体のスルホン化物においては架橋を行っているが、スルホン基導入量の増加に伴う担体の劣化が起り、所望の高強度を有し、しかも高スルホン基導入量を持つ、性能の良い担体を得る事ができなかった。

【発明が解決しようとする課題】

キトサンは蛹酸、酢酸、ジクロル酢酸等の水溶液に対して可溶性であるため、低pH域では損体として使用できず、安定に使用できる範囲は狭いものとなっている。又、フレーク状或いは粉末キトサンをスルホン化すると親水性が増大するため、 導入するスルホン基の量を極度に少なくしなければ損体として利用しうる水不溶性のスルホン化物を得る事ができなかった。

特間昭 63 - 274457号で開示した粒状多孔質 キトサン誘導体のスルホン化においては、架橋別のヘキサメチレンジイソシアネート 等により架橋 しているため全 pH 節域における安定性を得る事はできたが、スルホン基導入量の増加に伴う水溶性の増

加とこれによる強度の劣化が起り、スルホン試が溶解し、粒状を維持するのが困難となるみルホン化剤であるな気があった。また、該方法で用いられているスルホン化剤であるクロルスルホン酸は反応性がある場合を得るがあるののである。更に、スルホン量のでは、現性にも乏しいなりはながあった。

「100℃」で長時間反応させるため担体が劣化しまり、そしてキトサン中の割合には非特異吸符を生する等の問題があった。

本発明は上述の欠点を解決し、全pH領域において安定であり、強度が高く、所望のスルホン基を有するイオン交換例脂。クロマトグラフィー用担体に好適な粒状多孔質キトサン誘導体を容易に得ることを目的としてなされた。

【課題を解決するための手段】

本発明は、低分子量キトサンを酸性水溶液に溶

解し、該溶液を塩基性溶液中に落下、凝固させた 粒状多孔質キトサンを、無水酢酸によりアセチル 化後、ジェポキシで架橋し、次いでN,N'ージメチ ルホルムアミド中においてN,N'ージメチルホルム アミドー三酸化イオウ複合体によりスルホン化す ることを特徴とするスルホン語を有する粒状多孔 質キトサン誘導体を製造する方法である。

本発明の粒状多孔質キトサンは、平均分子量

10,000~ 230,000の低分子化キトサンを用いる。 この低分子化キトサンを酢酸,ジクロル酢酸, 繊 酸等の単独域いは混合物に溶解して 2~10%の水 溶液となるように調整する。該キトサン水溶液を 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリ ウム、炭酸カリウム、アンモニア、エチレンで ミン等のアルカリ性物質を含む塩基性水溶液中に 0.15 mm 中孔径のノズルより圧力下で粒状体を充 分水洗し粒状を入り、サンを得る。尚、塩基性 水溶液中にメタノール、エタノール等のアルコー ル類を併用する事も可能である。 上記のようにして得た粒状多孔質キトサンをアセチル化するため、これを無水酢酸と反応させて脱アセチル化度を10%以下、好ましくは 5%以下とする。アセチル化を行う際の有機溶媒は無水酢酸や反応生成物に対して不活性であり、アセチル化の反応に対し何ら影響を与えない不活性溶媒であればよく、例えばN.N'-ジメチルホルムアミド・ペンゼン・ 1.4-ジオキ

サン、メタノール、エタノール。 n - ブタノール 等を単独又は混合して使用できる。尚、この時の 脱アセチル化度が10%を超えると遊離のアミノ基 がスルホン化後も多く残存してしまうため、陽イ オン交換樹脂として用いる場合には、非特異吸替 の問題を生じるので、脱アセチル化度は10%以下、 好ましくは 5%以下である事が望ましい。

このようにして得られた限アセチル化度が10%以下の粒状多孔質 キトサンに 架橋削としてエピクロルヒドリン。エチレングリコールジグリシジルエーテル。ポリエチレングリコールジグリシジルエーテルなどのジェポキシを用い、脱アセチル化

した粒状多孔質キトサンの水酸基と反応させる方 法がとられる。その他にもヘキサメチレンジイソ シアネート、ジフェニルメタンー4,4'ージイソシ アネート、ジカルポン酸ハロゲン化物等を使用す る方法があるが、エーテル結合により架橋される ため化学的に非常に安定である点、架橋後非常に 高強度の退体が得られる点、架橋方法が簡便であ る点からエピクロルヒドリン、エチレングリコー ルジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコー ルジグリシジルエーテル等のジェポキシを用いる のが最適である。一方スルホン化剤としてはN.N' ・ジメチルホルムアミド中に三酸化イオウを滴下 して得られるN,N'-ジメチルホルムアミド-三酸 化イオウ複合体を用いる。その他にピリジン中ク ロルスルホン酸を使用する方法、ジクロルエタン 中クロルスルホン酸を使用する方法, N.N'-ジメ チルアニリンー無水硫酸複合体を使用する方法。 無水亜硫酸と無水硫酸の混合物を使用する方法。 硫酸とクロルスルホン酸の混合物を使用する方法 等が考えられるが、スルホン化剤が長期間安定に

【実 施 例】

以下、本発明を実施例により詳細に説明するが、 本発明は実施例記載の範囲に限定されるものでは ない。また、スルホン基を有する粒状多孔質キト サン誘導体の陽イオン交換容量(中性塩分解能)。

キトサン酢酸水溶液の粘度, みかけの弾性率は下 記のようにして求めた。

<陽イオン交換容量>

予め正確に膨潤体積を測定した試料をカラムに充塡し、約1N硝酸を SV50で通液する。純水で流出液の pHが中性を示すまで SV 100で通液し、次に約1Hの塩化ナトリウム水溶液を SV50で通液する。この時流出液はメスフラスコで正確に 1 2 割りとる。

このうちの50m2をフェノールフタレインを指示薬 として1/10 N- 水酸化ナトリウムで滴定を行い、 次式から関イオン交換容量(CTV) を求めた。

CIV(
$$\mu$$
 og/ ml) = $\frac{a \times f \times \frac{1}{10} \times \frac{1000}{50} \times 1000}{V}$

a:試験液50㎡を中和するのに変した1/10 M 水酸化ナトリウム量 (m2)

f: 1/10 N水酸化ナトリウム溶液の力価

V:試料の湿潤体積(n2)

< 粘 度 >

回転円筒形粘度計を用い20℃にて測定した。

< みかけの強作率>

レオメーターNRH-2010J-CW(不動工業株式会社製)により直径 3.5 mm。 深さ 2 mm の穴に雑紙上で水を除去した試料を詰め、直径 3.0 mm の円柱状の棒で 2 cm/minの速さで圧縮し、圧縮応力曲線を求め、該10%変形点での接線の傾きから求めた。 実施例 1.

股アセチル化度78%のキトサン65gを 3.25 %

計 酸水溶液 935gに溶解した。この時の粘度は
 2.300cpであった。該溶液を 6%水酸化ナトリウム・20%エタノール、74%の水からなる混合溶液中に 0.15 mm 中の孔径のノズルから落下し、キトサンを粒状に凝固再生させた後、中性になるまで水洗し、平均粒径 0.3mm 中の粒状多孔質キトサン 100㎡(湿潤状態)をエタノール中12.4gの無水酢酸と24時間室温で反応後、1Nー水酸化ナトリウム水溶液で 1時間処理し、脱アセチル化度 5%の粒状多孔質キトサン80㎡を得た。

こうして得られた脱アセチル化度 5%の粒状多

孔質キトサン80㎡ (温潤状態)を 1.4-ジオキサ ンで洗浄し、 1.5gのエピクロルヒドリン 8歳の 1N-水酸化カリウム水溶液を加え室温で16時間反 応させた後、更に80℃で 1時間反応させて架構さ せた。水洗後N.N'-ジメチルホルムアミドで洗浄 後 N. N'- ジメチルホルムアミド 12中に三酸化イ . オウ80g を加えたN. N' - ジメチルホルムアミドー 三酸化イオウ複合体18㎡を含むH.N'-ジメチルホ ルムアミド溶波80歳を加え、室温で 4時間反応さ せ、 N,0-スルホン化を行った。反応核了後冷却 しながら1N-水酸化ナトリウム水溶液で中和後充 分水洗し、スルホン基を有する粒状多孔質キトサ ン誘導体48㎡を特た。このものの陽イオン交換容 **品は80.0μeg/ nt. みかけの弾性率は 3.2×10^b** dyn/alであった。ここでスルホン化する際に加え るN.N'-ジメチルホルムアミド--三酸化イオウ複 合体量を18㎡から20㎡に変え、同一操作で3つの 試料を得た。3つの試料について夫々の陽イオン 交換容量を測定したところ、 105.0 μ eq/ et.

100.8μeq/me. 102.8μeq/meであり、極めて

ー水酸化ナトリウム水溶液で中和後充分水洗し、スルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体27 cdを得た。このものの陽イオン交換容量は 120.5 μeq/cd, みかけの弾性率は 3.0×10⁸ dyn/cdであった。またこのスルホン基を有する粒状多孔質キトサンを 0.1M 酢酸水溶液及び 0.1M 水酸化ナトリウム水溶液に懸濁しても溶解する事なく全pH 領域で安定な担体であった。

また、上記のようにして得られた架橋反応後の 粒状多孔質キトサン誘導体をスルホン化する際加 えるN,N'ージメチルホルムアミドー三酸化イオウ 複合体量を、 4 ml 。 6 ml 。 8 ml 。 12 ml 。 16 ml と夫 々変えてスルホン化を行ったところ、得られたス ルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体の限 イオン交換容量は、夫々29.2 μ eq/ml 。 71.3 μ eq /ml 。 151.0 μ eq/ml 。 228.9 μ eq/ml 。 310.0 μ eq/ml で、それらのみかけの弾性率が夫々 3.0 μ 10 dyn/ml 。 2.8 μ 10 dyn/ml 。 2.8 μ 10 dyn/ml 。 2.8 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.7 μ 10 dyn/ml 。 2.6 μ 10 dyn/ml 。 2.8 μ 10 dyn/ml dyn/ml 。 2.8 μ 10 dyn/ml dyn/ 再現性のよいスルホン基を有する粒状多孔質キトサンが得られることが明らかであった。得られた計 4種のスルホン基を有する粒状多孔質キトサンを、 0.1 N酢酸水溶液及び 0.1 N水酸化ナトリウム水溶液に懸濁しても全く溶解することがなく、全pH額減で安定なスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体であった。

実施例2.

実施例 1 と同様にして股アセチル化度 5%の粒状多孔質キトサンを得、その50㎡(温潤状態)を1,4-ジオキサンで洗浄し、1.76 gのエチレングリコールジグリシシルエーテル。 5㎡の1N-水酸化カリウム溶液を加えてで16時間反応させ架構させた。水で投入アミド 10㎡では大きないが、一ジメチルホルムアミド 10㎡をで洗りますが、10㎡を対した。10㎡では、10㎡を対し、10㎡では、10㎡で

上記のN,N・一ジメチルホルムアミドー三酸化イオウ複合体の添加量と得られた粒状多孔質キトサン誘導体の陽イオン交換容量の関係を第1回に示した。このことからスルホン化剤の量を変える事でスルホン基導入量を任意に変える事ができ、加えてスルホン基が高導入量となった際にも担体強度があまり低下していないことが判明した。

比较例1.

このものの限イオン交換容品は夫々 28.8 μ eq / m². 72.6 μ eq / m². 150 μ eq / m². みかけの弾性 零は 夫々 1.3 × 10 6 dyn/cd. 1.3 × 10 6 dyn/cd. 1.0 × 10 6 dyn/cd. 1.0 次 10

比较别2.

比較例 1 で示したスルホン化法において無水ビリジン 120㎡に対して加えるクロルスルホン酸量を 3㎡、 3.5㎡。 4㎡、 4.5㎡と変えてスルホン化を行ったところ、得られたものの関イオン交換容型は夫々26.5μeq/㎡、 6μeq/㎡、 92.5μeq/㎡、 98.2μeq/㎡、 その結果を第 2 図に示した。またクロルスルホン酸量を 5㎡に変えて同一操作で 3 つの試料を得た。この関イオン交換容型は夫々 180.0μeq/㎡。 65.3μeq/㎡、 98.2μeq/㎡であり再現性に乏しかった。この結果、比較例 1 のスルホン化法においてはスルホン化量を変

第2図は、比較例2におけるスルホン化剤風と陽 イオン交換容量との関係を示すグラフである。

えても所望の陽イオン交換容量の多孔質粒状キト サン誘導体を得ることは容易でないことが明らか である。

【発明の効果】

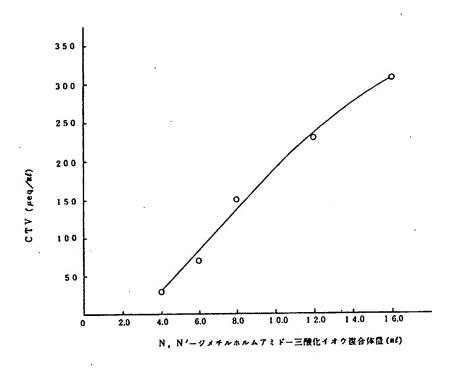
本発明によって得られるスルホン基を有する粒 状多孔質キトサン誘導体は全門領域においても安 定であり、イオン交換樹脂、クロマトグラフィー 用担体として好適な強い強度を持つものである。

本発明のスルホン基を有する粒状多孔質キトサン誘導体は、実施例及び比較例の記載から明らかなように、従来のスルホン化法で得られたものに
校べて全別域で安定であるばかりでなく、強度的
に 2~ 3倍の性能を有するものである。更に本発
明方法においてはスルホン化剤の使用量を変える
ことにより、スルホン基準入量を再現性良く任意
に調整でき、所望の陽イオン交換容量を有する多
孔質粒状キトサン誘導体を製造することができる。

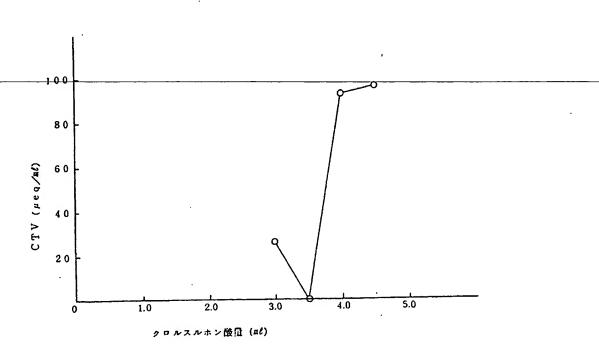
4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の実施例2 におけるスルホン 化剤量と陽イオン交換容量との関係を示すグラフ、

第 1 図



第 2 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)